

ЧУМХУРИИ
ТОЧИКИСТОН



ИДОРАИ
ДАВЛАТИИ
ПАТЕНТӢ

ГУВОҲНОМА

Шаҳрванд Акобирова А.

муаллифи ихтирои *Маводи композитсионии рӯшноитобовар*

Ба ихтироъ
нахустпатенти № TJ 437

мебошад
дода шудааст.

Дорандай
нахустпатент Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Сарзамин Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳаммуаллиф(он) Рашидов Дж., Туйчиев Ш., Мисриён С.

Аввалияти ихтироъ 13.07.2010

Таърихи рӯзи пешниҳоди ариза 13.07.2010

Аризай № 1000498

Дар Феҳристи давлатии ихтироъҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

5 июля 2011 с. 2011 ба қайд гирифта шуд
Нахустпатент
эътибор дорад аз 13 июля 2010 то 13 июля с. 2020

Ин гувоҳнома хангоми амали гардонидани хуқуқу имтиёзхое, ки барои муаллифони ихтироот бо қонунгузории ҷорӣ мукаррар гардидаанд, нишон дода мешавад

ДИРЕКТОР

Негматуллаева Н.Б.





СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ СССР ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
(ГОСКОМИЗОБРЕТЕНИЙ)

ПАТЕНТ

№ 1794323

На основании полномочий, предоставленных Правительством СССР,
Госкомизобретений выдал настоящий патент на изобретение:

"Способ изготовления пленочных детекторов ионизирующего излучения на основе теллурида кадмия"

Патентообладатель: Таджикский Госуниверситет

Автор (авторы): Акобирова Азиза Ташпулатовна, Обухов Юрий
Валерьевич, Султанов Низом Султанович и Хусайнов
Абдурахман Хусаинович

Заявка № 4917624 Приоритет изобретения 11 марта 1991г.
Зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений СССР

8 октября 1992г.
Действие патента распространяется на всю
территорию Союза ССР сроком на 20 лет

(с 11 марта 1991г.)

Председатель Комитета

Начальник отдела

"УТВЕРЖДАЮ"

Гл. инженер НИИТТ



А.И. Сухопаров

X/ 1993 г.

А К Т

о внедрении результатов диссертационной работы
ГАДОЕВА С.М.

Настоящий акт составлен в том, что результаты диссертационной работы Гадоева С.М., а именно:

- модель защелкивания паразитных 4-х слойных структур в КМДП ИМС, пригодная для использования в широком диапазоне температур, а также варианты моделей для использования в КМДП ИМС различных технологий;
 - методику расчетной идентификации параметров моделей в диапазоне температур до 350-400°K, подтвержденную экспериментально;
 - методику проведения эксперимента на лазерном имитаторе высокоэнергетического ИИ, позволяющую достоверно контролировать параметры защелкивания 4-х слойных КМДП структур в диапазоне температур от 200 до 400°K при интенсивности облучения до 10^{12} рад(Si)/с,
- переданные по договору на ОКР "Такт-ПЗУ256КР", внедрены в НИИТТ при разработке БИС ПЗУ высокой информационной емкости.

Внедрение результатов диссертационной работы Гадоева С.М. позволило выявить основные закономерности температурной зависимости ионизационной реакции КМДП ИМС, выбрать и отработать методику контроля температурной зависимости параметров защелкивания паразитных четырехслойных структур и получить экспериментальные данные на тестовых образцах и готовых изделиях.

Начальник отдела

П.Н.Гафаров

Начальник лаборатории

В.Н.Гуминов